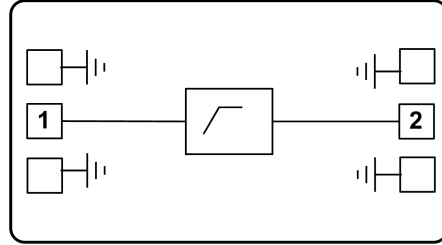




主要特点

- 通带频率: 12 - 40 GHz
- 通带损耗: $\leq 2.1\text{ dB @ 12 GHz}$
- 阻带衰减: $\geq 15\text{ dB @ 10 GHz}$
 $\geq 42\text{ dB @ 8 GHz}$
- 输入/输出: 50 Ohm 匹配
- 芯片尺寸: $1.5 \times 1 \times 0.1\text{ mm}^3$

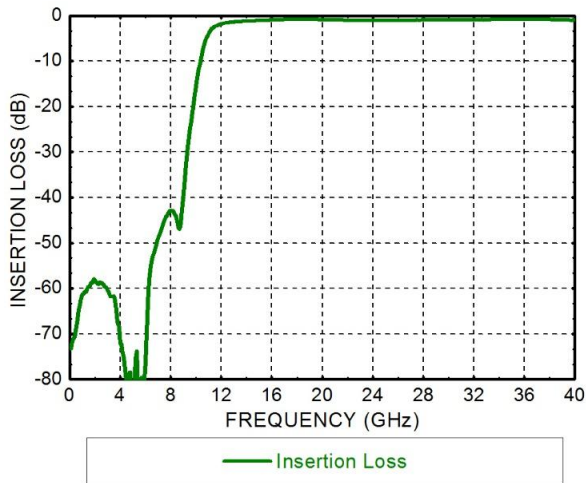
功能框图



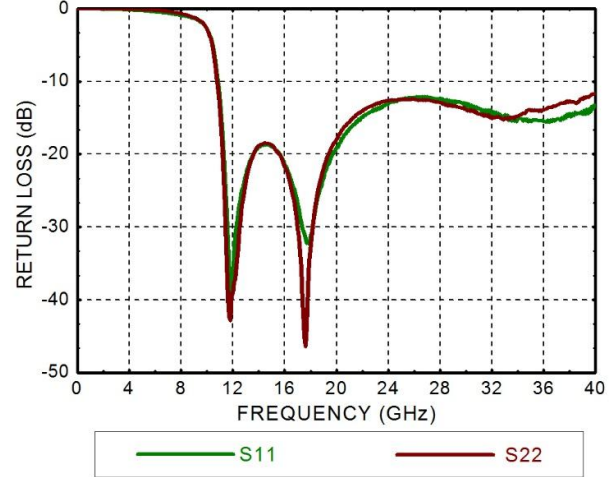
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	12 - 40			GHz
插入损耗		1	2.1	dB
阻带衰减 @10GHz		15		dB
阻带衰减 @8GHz		42		dB
回波损耗	12	15		dB

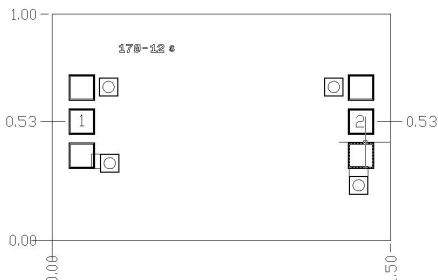
插入损耗



回波损耗



物理参数



极限参数

最大输入功率	+30 dBm
存储温度	-65 ~ +150° C
工作温度	-55 ~ +85° C